PAT-NO:

JP403050549A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03050549 A

TITLE:

PHOTORESIST COMPOSITION

PUBN-DATE:

March 5, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MEIER, KURT

LUNN, ROBERT J

KROEHNKE, CHRISTOPH

EUGSTER, GIULIANO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

CIBA GEIGY AG N/A

APPL-NO: JP02157374

APPL-DATE: June 15, 1990

INT-CL

G03F007/027, C08G018/67, C09D004/00, C09D005/00, C09D011/10, C09D175/00,

**(IPC)**:

G03F001/10, G03F007/028, G03F007/033, H01L021/027

# ABSTRACT:

PURPOSE: To form an image of high resolution and to ensure low brittleness and high thermal and chemical resistances after heat curing by modifying a photosetting compsn. with a binder and a

CONSTITUTION: This photoresist compsn. is a photopolymerizable and solvent-developable compsn. consisting of a photopolymerizable (meth) acrylate, a photoinitiator for the (meth) acrylate, an org. polymer binder contg. free carboxyl groups and having an acid value of at least 60, a blocked polyisocyanate having at least 100°C cleavage temp. as a crosslinking agent and an inert solvent enough to pour the compsn. An image of high resolution is formed and low brittleness and high thermal and

COPYRIGHT: (C)1991,JPO

# ⑩ 公開特許 公報 (A) 平3-50549

⑤Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 ⑥公開 平成3年(1991)3月5日 G 03 F 7/027 5 0 2 C 08 G 18/67 NFA 7602-4 J 2104-5F H 01 L 21/30 3 0 1 R※ 審査請求 未請求 請求項の数 11 (全11頁)

**93発明の名称** フォトレジスト組成物

②特 頭 平2-157374

②出 願 平2(1990)6月15日

優先権主張 Ø1989年6月16日 Øスイス(CH) Ø2254/89-0

**②発明者 クルト マイヤー スイス国,4106 テルヴイル,シュテフアンストラーセ** 

66

@発 明 者 ロパート ジェイムス イギリス国,ケンブリッジ シーピー38ティージェイ,バ

ラン ー ヒル, ヲーター ミード 24

**⑫発 明 者 クリストフア クロエ ドイツ連邦共和国,7800 フライブルク/ムンツインゲ** 

ンケ ン, セント エレントルデイス ストラーセ 24

の出 顋 人 チパーガイギー アク スイス園 パーゼル市 クリベックストラーセ 141

チェンゲゼルシヤフト

②代理人,并理士 萼 優美 外2名

最終頁に続く

引 和 書

1. 発明の名称

フォトレジスト組成物

- 2. 特許請求の範囲
  - (i) a) 光重合性アクリレート又はメタクリレート、
    - b) 成分a) のための光閉始剤、
    - c) 避豫のカルポキシル基を含み且つ少なくと も80の微値を有するポリマー状有機結合剤、
    - d) 架橋剤としての、少なくとも100℃の関 交進度を育するブロックトポリイソシアネー ト、及び
    - e) 光重合性組成物を注ぎ得るような量の不活性溶媒からなる光重合性及び溶媒現像性組成物。
  - (2) 成分a) が次式Ⅱ:

$$A-R_{\bullet}-(A). \qquad (I)$$

[式中、nは2,3又は4を扱わし、R:は官 蛇性基を除いた後の腔筋族又は関環式n値アル コール茶を扱わし、そしてAは次式Ⅰ:

(式中、R」は水素原子又はメチル基を表わし、そしてXは-0-基を扱わす)で表わされる化合物を表わす、請求項1記載の組成物。

- (8) アクリレート基及び/又はメタクリレート基 以外に、成分 a) が更にイソシアネートに対し て反応性である官能性差、特に避難のカルボキ シル基又はアルコール差を含む、請求項 I 記載 の組成物。
- (4) 成分 b ) がペンゾイン、ペンゾインアルキルエステル、αー散換アセトフェノン、特にαーハロゲン化アセトフェノン、αーアミノ宣換アセトフェノン、ジアルコキシアセトフェノンはαーヒドロキシアセトフェノン;ペンゾフェノン、チタノセン開始剤、光湿元性染料を配合したスタナン;キノン又はαー炭素原子上に少

なくとも一つの水来原子を有するアミンを配合 したチオキサントン;チオキサントン及びアク リルフォスフィンオキシドからなる群から選ば れた、請求項1記載の組成物。

- (5) 成分 c) が可溶性であるアルカリ性水性媒体 例えばアルカリ性水性溶媒中で現像することが できる、謝求項1配載の組成物。
- (6) 成分 c ) がアクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸又はイタコン酸をベースとするホモポリマーと、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸又はイタコン酸及びスチレン又は育配酸のエステル、特にそのアルキルエステルをベースとするコポリマーとからなる群から選ばれた、アルカリ性水性媒体中で現像することができる、請求項5 配載の組成物。
- (T) 成分 c) が同一分子中に兼権のカルポキシル 差及びアグリル基又はメタクリル基を含むポリ マー状有機結合剤である、請求項1配載の組成 物。
- (B) 成分 d ) がそのイソシアネート基が B ジカ

塗裏の非照射領域よりも可溶性を小さくする 工程と、

- iv) 本発明の組成物のための溶媒を用いて、好ましくはアルカリ性水性現像液を用いて強膜を処理することにより微膜の非無射領域を除く工程と、
- ▼)照射された組成物を完全に架橋させるため にブロックトポリイソシアネートの開発温度 以上の温度に現像された塗膜を加熱する工程 とからなる、レリーフ構造の製造方法。
- 加 光機造形成性ソルダーレジスト又はパーマネントレジストの製造のための、請求項1記載の組成物の使用方法。
- 3. 発明の詳細な説明
  - (産業上の利用分野)

本発明は、特にソルダーレジストとして逃する新規な、現像可能なフォトレジスト組成物に関するものである。

(従来の技術及び発明が解決しようとする課題) 避離禁の手段により重合することができる化 ルポニル化合物、ヒドロキサメート、チアゾール、イミダゾール、イミダゾリド、テトラヒドロピリミジン、ラクタム、オキシム、ヒドロキシイミド、フェノール又はチオフェノールにより閉塞された間防族、貯取式、芳香族又は芳香 間防族ジー、トリー又はテトライソシアネートである、鬱水蛋1記載の組成物。

- (9) 成分d)が100℃と160℃の側の開発型 度を有し且つオキシム閉塞ポリイソシアネート 、特にジイソシアネートである、請求項1記載 の組成物。
- (図i) 請求項1記載の組成物を基材表面に塗布する工程と、
  - 立)好ましくは論市された基材を加熱することにより、溶媒を)の大部分を蒸発させて強市された基材を乾燥し、その結果溶媒を)を実質的に除いて非粘着性の表面を形成する工程と、
  - 団) 化学線を用いて感光性治験を関像化照射し、その結果治験の照射領域を光度合させ且つ

Co. Target

合物を、及びブロックトポリイソシアネートをベースとする無溶媒の光硬化性組成物は特開昭 5 4 - 1 3 2 8 3 3 号公報に関示されている。 前記組成物は差材に構造化形態で塗布され、 終いて U V 服射を使用して硬化する。 それらは、とりわけソルダーレジストとして使用することができる。 現像可能な系は前配文献中には関示されていない。 構造化形態で塗布されたレジストは、一般的に現像可能なレジストよりも低い分解能を有している。

BP-A-115354には、集機剤として アルデヒド総合機関先駆物質と酸茎を含む選ば れた結合剤とを含む(メタ)アクリレートをペ ースとするフォトレジストが関示されている。 これらの組成物は室温で長い保存寿命を有し且 つ他方で、この種のレジストのための比較的低 い温度において硬化させることができる。

フォトレジストは一般的にラミネート化によ り、又は溶液から蒸材に依布される。 育配要金 工程において、レジストは適常例えばラミネー ト化操作の国又は溶放から塗存は一般的に光操なの悪発は一般的に光操ない。部分的な架像は一般的に光操器である。部分的な架像は非暴傷ので、これは国際においてさえも起こるので、これは国際においてさえも起こるので、この熱処理において可能な限り小かってを起こしい性質ということが、フォトレジストの望まいて同時による。他方、使用された姿置によって同時によるのである。他方、使用された姿置によるとが望まったのである。とが観れている。とが観れている。とが観れているといい。

#### (課題を解決するための手段)

公知の光硬化性組成物は選ばれた結合剤と架 機剤とを使用することにより変性することがで き、これは長い保存寿命を有し、溶液から製造 することが簡単であり、そしてこれを使用する ことにより高分解能の関係を得ることができ、 そしてこれは無硬化铁の低い脆性並びに高い熱。 的及び化学的抵抗性を特徴とするということが

e) 光重合性組成物を注ぎ得るような量の不活性溶媒からなる光重合性及び溶媒現像性組成に関するものである。

成分 a) ないしe) は、各々個々の化合物の 形態であってよい。しかしながら、それらの化 合物のいくつかの混合物、例えばいくつかの ( メタ) アクリレートの混合物を用いることもで まる。

成分 a) は、それが光重合性、すなわち特に UV及び/又はVIS服射により架構され且つ 不溶性の生成物に変換することができる限りは 、モノマー状又はオリゴマー状(メタ)アクリ レートであってもよい。

それらは、特に二つ又はそれより多くの次式 I:

(式中、R」は水素原子又はメチル基を表わし

今中見出された。

へキサメトキシメチルメラミンを使用して硬化したソルダーレジストと比べて、本発明のレジストは、驚くべきことに、高い潜在性を特徴とする。それ故、これらのレジストの強跳は比較的高沸点溶媒からできえも流布し、続いて100℃以上の温度で急速に乾燥することができる。始襲のために利用可能な溶媒の数は、それ故増加する;特に、非ハロゲン化溶媒を用いるとができる。特定の強装方法のためには、例えばカーテン強布又はスクリーン印刷を使用しなければならない。

本発明は、

- a) 光重合性アクリレート又はメタクリレート、
- b)成分a)のための光開始剤、
- c) 兼職のカルポキシル基を含み且つ少なくと も 8 0 の酸価を有するポリマー状有機結合剤、

、Xは-NR<sub>3</sub>-基そして特に-O-基を表わ し、そしてR<sub>3</sub>は水素原子又は炭素原子数 1 ないし8のアルキル基を表わす)で表わされる官 能性基を含む化合物である。

式Iで表わされる基を含む化合物は、一般的に脂肪族、脂環式、芳香族又は芳香脂肪族ポリアルコール又はポリアミンをベースとするエステル又はアミドである。

モノマー状又はオリゴマー状成分 a) は、フォトレジストの当業者に公知であり、そして例 えばEP-A-115854に関示されている。 好ましい成分 a) は、次式 II:

$$A-R_{\bullet}-(A). \qquad (I)$$

(式中、Aは式Iで表わされる基を表わし、nは2,3又は4を表わし、そしてR。は官能性基を除いた後の暫防族又は耐環式n領アルコール基を表わす)で表わされる化合物である。

基RIの例はエチル基、nープロピル基、イ ソプロピル基、nープチル基、第二プチル基、 n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチ ル基、n-オクチル基及び、特にメチル基である。

表R,のペースとなる数数後アルコールの例は、アルキレンジオール例えば1、2-エタンジオール、1,2-プロパンジオール、1,3-プロパンジオール、1,5-ペンタンジオール、1,6-ペキサンジオール、1,6-ペンタンジオール、1,6-ペキサンジオール、1,8-オクタンジオール、1,12-ドデカンジオール、1,12-ドデカンジオール、1,12-ドデカンジオール、1,12-ドデカンジオール、1,12-ドデカンジオール、1,12-ドデカンジオール、1,12-ドデカンジオール、ジー又はトリエチレングリコール、トリングリコールである。

表R。のペースとなる関環式アルコールの例は、1,8-又は1,4-シクロヘキサンジオール又は1,4-ジメチロールシクロヘキサンである。

特に、ジアルコキシアセトフェノン例えばジエ トキシアセトフェノン、又は特に、αーヒドロ キシアセトフェノン例えば1-ヒドロキシシク ロヘキシルフェニルケトン:又はペンソフェノ ン例えばペンゾフェノンそれ自体又はピス(1 - ジメチルアミノ) ペンゾフェノン:又はメタ ロセン開始利例えばチタノセン開始利例えばビ ス (πーメチルシクロペンタジエニル) ピス ( 又は光道元性染料を配合したスタナン例えばメ チレンブルー又はペンガルピンクを配合したト リメチルペンジルスタナン;又はキノン若しく はαー炭素原子上に少なくとも一つの水素原子 を有するアミンを配合したチオキサントン例え はアントラキノン、ペンソキノン又はピス(4) - ジょチルアミノ) ペンゾフェノン若しくはト リエタノールアミンを配合したチオキサントン : 又はチオキサントン例えばアルキルー若しく はハロゲン置換チオキサントン例えば2-イソ プロピルチオキサントン若しくは2-クロロチ

アクリレート基及び/又はメタクリレート基 に加えて、特に好ましい成分 a )はイソシアネ ートに対して反応性の付加的官能性基、例えば アミノ基、特に避難のカルボキシル基又はアル コール基を含む。これらの例は、その中で扱つ かのアルコール基のみがエステル化された上述 のポリアルコールの(メタ)アクリレートであ

用いることができる光閉始解 b)は、避嫌差 重合において慣用の全ての閉始剤である。

適する光閉始剤 b)の例は、芳書族カルボニル化合物例えばペンゾイン、ペンプインアルキルエーテル例えばイソプロピル又はαーブチルエーテル、αー酸換アセトフェノン特にペンジルケタール例えばペンジルジメチルケタール、又は特に、αーハロゲン化アセトフェノン例えばトリクロロメチルアー第三ブチルフェニルケトン、又は特に、αーアミノ酸換アセトフェノン例えばジメチルアミノメチルフェニルケトン、又はモルフェリノメチルフェニルケトン、又はモルフェリノメチルフェニルケトン、又は

オキサントン;又はアシルフォスフィンオキシ ドである。

成分 c )は、それらが少なくとも 6 0 の酸価を有し且つそれ故例えば現像液に可溶性である限りは、遊離のカルボキシル基を含む種々の有機ポリマー状結合解であってよい。結局局、結局の独自の指針を表現して、対して、変更の変更を含む、エチレンを含まる。そのリル酸、マクリル酸、アクリン酸素を含まない。

ートは、好ましくはノボラック又は非変性若しくは変性ピスフェノールAをベースとするエポキシ化合物と、アクリル酸又はメタクリル酸との反応生成物を意味するものと理解されたい。これらのエポキシ(メタ)アクリレートは、次いでカルボン酸無水物、例えばテトラヒドロフタル酸無水物、ヘキサヒドロフタル酸無水物、ピロメリト酸二無水物又はペンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物と反応させる。この種のポリマー状結合剤は、BP-A-292219及びGB-A-2175908に開示されている。

同一分子中に避難のカルポキシル基及びアクリレート基又はメタクリレート基を含む別の結合利の例は、スチレンーマレイン酸無水物コポリマーとヒドロキシ(メタ)アクリレート、例えば2ーヒドロキシエチル(メタ)アクリレート又は3ーヒドロキシプロピル(メタ)アクリレートとの反応生成物である。この種のポリマー状結合利は、BP-A-287019に関示

ーである。別の適するポリマー状結合剤 c )は 、EP-A-115854に既示されている。

使用される架機剤d)は、少なくとも100 での開發温度を有するブロックトポリイソシア ネート、又はこの種のポリイソシアネートの混合物である。本明細書中において、これは少な くとも半分のイソシアネート基が100での温度で説開塞化により再放出され且つフォトレジ ストの他の化合物のイソシアネート反応性官能 性基との反応に利用し得るブロックトポリイソ シアネートを意味するものと理解されたい。

閉塞された成分 d) がペースとするポリイソシアネートは、イソシアネート基に対して不活性な別の置換基例えばアルキル基若しくはアルコキシ基又はハロゲン原子を含み得る少なくとも二つ、好ましくは二つないし四つのイソシアネート差を有するいずれかの間妨後、間隔式、芳香族又は芳香器防族化合物であってよい。

これらは、例えば下記の化合物を包含する: 2,4-ジイソシアナトトルエン、及び2,6 されている。

ポリマー状結合剤 c) は、一般的に約200 0ないし5000の分子量(数平均)を有 している。

好ましい結合剤 c) は、アルカリ性水性溶媒 に可溶性のものである。水溶液中で現像し得る フォトレジストは、この種の結合剤を使用して 製造することができる。このようなレジストが 特に好ましい。

これらの特に好ましい結合剤 c)は、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸又はイタコン酸をペースとするホモポリマー、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸又はイタコン酸とスチレン又は胸記酸のエステル、特にそのアルキルエステルとをペースとするコポリマーを包含する。

本発明において使用すべき結合剤のうちの扱 つかは市販されている。これらの例は、カルポ セット®(Carboset®)型及びスクリ プセット®(Scripset®)型のポリマ

- ジィソシアナトトルエンとのその工業級混合 物、2,8-ジイソシアナトトルエン、1,5 - ジイソシアナトナフタレン、 4 , 4' - ジイ ソシアナトジフェニルメタン及び種々のジイソ シアナトジフェニルメタン(例えば4,4′-及び2,4°-異性体)の工業級混合物、ジイ ソシアナトーmーキシリレン、N, N' - 2( 4-メチルー3-イソシアナトフェニル)尿素 、1, 8-ジイソシアナトヘキサン、8, 5, 5, -トリメチル-1-イソシアナトメチルシ クロヘキサン (イソフォロンジイソシアネート )、トリメチルー1、6-ジイソシアナトヘキ サン、1-メチルー2,4-ジイソシアナトシ クロヘキサン、ジメリルジイソシアネート、ト リイソシアナトトリフェニルメタン及び4,4. - ジイソシアナトジシクロヘキシルメタン。

これらのポリイソシアネートは、祖々の芸により閉塞されていてよい。通する閉塞成分の例は、 B - ジカルボニル化合物例えばマロネート、アセトアセテート又は 2 . 4 - ペンタンジオ

ン、又はヒドロキサメート、トリアゾール、イミダゾール、イミダゾリド、テトラヒドロビリミンン、ラクタム、オキシム、ヒドロキシイミド例えばN-コハク酸イミド、又はフェノール 若しくはトリフェノールである。

成分 d )は、それらの閉裂温度が 1 0 0 で以上である限りは、ウレタン化、カルボジイミド化若しくは二量化若しくは三量化ポリイソシアネートであってもよい。これらの例は、ウレタン化 4 ・ 4 ・ - ジイソシアナトジフェニルメタン、カルボジイミド化 4 ・ 4 ・ - ジイソシアナトトルエンのウレトジオン、 ジイソシアナトトルエンの三量体、N、N・、N・・トリ(8 - イソシアナトへソシアナトルエンのラはない、N・・、N・・トリ(8 - イソシアナトへソシアオート及び三量化ペキサンジイソシアネートである。

好ましい成分 d )は、100℃と160℃との間の開發温度を有する。

本発明の組成物における個々の成分の量は、 輻射線感受性混合物の性質及び塗布領域に応じ て広い制限範囲内で変化してよい。各々の場合 における下配の重量データは、特記しない限り 成分 a )ないし e )の全重量に関するものであ る。

重合性モノマー又はモノマー混合物 a) の量は、一般的に1~50重量%、好ましくは10~30重量%である。

開始剤成分b)の量は、成分a)の全重量に対して一般的に1~30重量%、特に5~20重量%である。

結合剤 c) の量は、一般的に10~70度量 %、好ましくは10~50度量%である。

架橋剤 d ) の量は、一般的に 2 ~ 2 0 食量% 、好ましくは 5 ~ 1 5 食量%である。

海媒 e) の益は、一般的に 5 ~ 8 0 重量%、 特に 1 5 ~ 8 0 重量%である。

本発明の組成物は、慣用の別の影加幇例えば 安定剤、増感剤、顔料、染料、充填剤、カップ 特に好ましい成分 d )は、オキシム閉塞ポリ インシアネート、特にジインシアネートである。

不活性溶媒 e) は、成分 a) ないしe) を溶 解しなければならず、そして光硬化性組成物を 注ぎ得るような量用いる。溶媒は、混合物の保 存寿命に関して不利な効果を有するべきではな く、それ故実質的に混合物成分に対して不活性 でなければならない。更に、それは基材にフォ トレジストを盤布後容易に除き得るように、可 蛇な及り低い蒸発点を有するべきである。資す る溶媒の例は、炭化水素例えば脂肪族炭化水素 例えばトリクロロエタン;又は芳香波袋化水素 例えばジクロロベンゼン;又はエステル例えば メチルグリコールアセテート、メトキシプロビ ルアセテート又はエチル3-エトキシプロピオ ネート:又はケトン何えばジイソプロピルケト ン又はシクロヘキサノン;又はアルコール例え はメチルグリコール又はメトキシプロパノール :又はラクトン併えばッープチロラクトン:又 はラクタム例えばN-メチルピロリドンである。

リング剤、施れ開整剤、水和剤及び可塑剤を含んでいてよい。そのような添加剤の量は、通常 全組成物に対して 0.01~50重量%である。

本発明の組成物は全ての複類の基材例えば木、織物、紙、セラミック、ガラス、プラスチック例えばポリエステル、ポリオレフィン、酢酸セルロース又はエポキシ樹脂、特にガラス繊維強化エポキシ樹脂のための、及び金属例えばAl、Cu,Ni,Fe,Zn,Mg又はCoのための、又は半導体材料例えばSi。GaAs又はGeのための、又は絶縁材料例えばSi。N4又はSi〇』のための被復剤として非常に適しており、ここで画像及び保護塗膜は暴露により形成されるべきである。

本発明は、

- i) 本発明の組成物を基材表面に塗布する工程 と、
- 前)好ましくは歯布された基材を加熱することにより、溶解e)の大部分を蒸発させて歯布された基材を乾燥し、その結果溶解e)を実

質的に除いて非粘着性の表面を形成する工程 と、

- 五)化学線を用いて感光性塗膜を調像化照射し、その結果塗膜の照射領域を光重合させ且つ 塗膜の非照射領域よりも可溶性を小さくする 工程と、
- ir) 本発明の組成物のための溶媒を用いて、好ましくはアルカリ性水性現像液を用いて塗膜を処理することにより塗膜の非照射領域を除く工程と、
- ▼) 願射された組成物を完全に架構させるため にプロックトポリイソシアネートの開桑温度 以上の温度に現像された後期を加熱する工程 とからなる、レリーフ構造の製造方法にも関 するものである。

被理差材は、例えば本発明の組成物の溶液又は懸渦液を調製することにより製造することができる。これは、一般的に公知の歯布方法により差材に均一に歯布する。歯布方法の例は、回転歯布、浸渍、ナイフ歯布、カーテン歯布、ブ

ように選ばれる。溶媒は、真空を用いて除くこともできる。

福射線感受性強膜は、続いて成分 a) を光重合させるために公知の方法により編射線に暴露する。これにより、一般的に画像化が行われる。成分 a) の光重合の結果として、溶解性は非基質関域に比べて強酸の暴露領域では減少し、その結果表面の差別化が可能となる。

本発明の組成物を、化学線を使用して暴露する。これは、一般的にUV線及び/又はVIS はである。約220~450nmの範囲の輻射線が好ましい。照射は、公知の全ての輻射線器例えば水銀高圧ランプとはUV/VISレーザーを使用して行うことができる。操作条件例えば照射時間及び輻射線器とも強度との距離は、一般的に輻射線器受性組成物の性質に依存するであろうし且で変とができる。関像化暴露は、フォトマスクを通して又はレーザービームによる直接を使用して見ばレーザービームによる直接を使用して異常は、フォトマスクを通して又はレーザービームによる直接を使用して異常は、フォトマスクを通

ラッシング、噴霧及びリパースロール盗布である。

全市量(金額の厚さ)及び基材(金布ベース)の種類は、所望の金布領域に依存する。本発明の組成物は、深い金額として金布することができ且つ良好な分解能を特徴とするので、特に有利である。風射源及び輻射線感受性成分が好適に選ばれた場合には、それらは構造形成されや画像が望まれる金布領域の広い範囲に対して演する。

しかしながら、それらの使用は光構造形成性 ソルダーレジストとして又はパーマネントレジ ストとして印刷された回路板の製造において特 に有利である。それらの使用は同様に本発明の 目的をなす。

施布操作後、溶媒は通常乾燥により除き、ベース上に非晶質施膜を得る。乾燥後のフィルムの厚さは、5~150μmが好ましい。乾燥は 通常高められた湿度で行われ、その湿度は通常 成分d)の実質的な脱閉塞化が全く起こらない

り、感光性塗験上に行うことができる。

暴露に続いて現象工程がある。現像液の作用により、フォトレジストの非暴露領域を除く。 照射され且つ部分的に硬化した組成物が不溶性 であるか又は部分的にのみ可溶性である非暴露 組成物のためのどの様な溶媒も現像液として適 している。

アルカリ性水性溶媒は、現像液として好ましい。これらは特に、アルカリ金属炭酸塩、水酸化物、珪酸塩及び燐酸塩の溶液を包含する。これらの溶液は、水和利及び/又は有機溶媒を比較的少量含んでもよい。

アルカリ金属炭酸塩の水溶液例えば1%炭酸ナトリウム溶液は、特に好ましい。

有機溶媒を使用する現像も同様に可能である。 適する溶媒の例は、ケトン例えばシクロヘキサ ノン、アセトン又はメチルエチルケトン、又は アルコール例えば2-エトキシエタノール、ジ アセトンアルコール又はジエチレングリコール モノブチルエーテルである。

T. .....

基準及び現像後、強悪に熱的な後処理を行う。 即ち塗膜を、架質剤 d ) が脱閉塞化し次いで閉 放されたイソシアネート基が結合剤c)のカル ポキシル基と、、及び存在する場合には成分a )の別のイソシアネート反応性差と反応するよ うな温度に加熱する。この工程の温度は、ブロ ックトポリイソシアネートの開製温度以上でな ければならず、そして用いる成分d)に応じて 選ぶ。各々の場合において、この工程の温度は 100℃より高く、120~180℃であるの が好ましい。

## 1. フォトレジスト結合剤ポリマーの合成 実施例1

ビスフェノールAジグリシジルエーテルとア クリル酸との反応生成物 5 4 . 5 1 g (0.1 1 2 5 モル〉を、ジオキサン1 3 1. 7 g に溶 解する。ジー第三プチルーパラークレゾール0 . 87gとペンゾフェノンテトラカルポン酸二 無水物 3 2. 2 g (0. 1 モル) を 7 0 ℃でこ の溶液に加える。反応混合物が沸騰した時、4

無水物 4 5、 8 g 及びヒドロキノン 0、 1 2 g 実施例 5 を、ジオキサン180mlに室温で溶解する。 4 - ジメチルアミノピリジン 0 . 18gを加え 、次いでこの混合物を24時間混流する。ポリ ・マーを水から比喩させ、次いで乾燥する。収率 は100%である。

#### 実施例 4

エポキシクレゾールノポラック(エポキシド 低4. 35当量/kg) 230g、アクリル酸 84.7g、ジー第三プチルーパラークレゾー ル 0 . 5 9 g 及びペンジルジメチルアミン 1 . 47 2 & .. エチルグリコールアセテート300 g中で110℃に3、5時四加熱する。この時 関中に、エポキシド値はO. 8当量/kgに低 下する。ヘキサヒドロフタル酸無水物131. 8g及び4ージメチルアミノピリジン1、05 gを続いて加え、次いでこの混合物を更に24 時間110℃で遊滅する。3. 2当量の酸がk 8当たりに認められた。

## Ⅱ、フォトレジストの製造及び性質

- ジメチルアミノビリジン 2 4 6 m g (2 ミリ モル)を触媒として加える。この混合物を26 時間遅流後、2.25当量の酸が反応生成物の kg当たりに認められ、そして反応は終了する。 実施例 2

ピスフェノールAジグリシジルエーテルとア クリル酸との反応生成物 5 4 . 5 1 g (0. 1 125モル)を、ジオキサン114gに溶解す る。ジー第三プチルーパラークレゾール 0.8 7 g とピロメリト酸二無水物 2 1. 8 1 g ( 0 1 モル) を70℃でこの溶液に加える。反応 混合物が沸騰した時、4-ジメチルアミノビリ ジン248mg(2ミリモル)を触媒として加 える。この混合物を2.6時間澄波後、2.25 当量の酸が反応生成物のkg当たりに認められ 、そして反応は終了する。

#### 突施例 3

育駆したピスフェノールAジグリシジルエー テル (軟化点70~80℃) とアクリル酸との 反応生成物87、7g、テトラヒドロフタル酸

シクロヘキサノン53.28中にスクリプセ ットΦ (ScripsetΦ) 550 (スチレ ンとマレイン酸をペースとする部分的にエステ ル化されたコポリマー, モンサント (Mons anto) 製) 9. 2g、スクリプセットの ( Scripset 1) 540 (スチレンとマレ イン酸をベースとする部分的にエステル化され たコポリマー, モンサント (Monsanto ) 製】 7. 9 g、テトラエチレングリコールジ メタクリレート 3. 0g、トリメチロールプロ パントリアクリレート2.0g、ウルトラミッ クス(Ultramix) タルク(サイプラス (Cyprus)) 8. 4g、染料(オラソー ルプルーGN (Orasol Blue GN **):チバーガイギー(C1BA-GB1GY) 〕 0. 21g、ペンタエリトリトールトリアク** リレート3. 2g、2-メチル-1-(4-( メチルチオ) フェニル} - 2 - モルフォリノブ ロパン-1-オン1.5g、ブタン-2-オン

O, O' - (メチレンピス (1、4-フェニレンイミノカルボニル) 〕 ジオキシム4、8g、及び4、4' - ピス (ジエチルアミノ) ペンゾフェノン0、2gを含む溶液を、ナイフ強布具を使用して回路板に強布する。このフィルムを、続いて5分間100℃で乾燥する。この様にして得られた強膜を水銀高圧ランプを使用して15秒間マスクを通して暴露する(試料を1%炭酸ナトリウム水溶液中で現像し、次いで140℃で1時間硬化させる。良好なソルダーバッチ抵沈性(270℃で1分)及び30分よりも長い塩化メチレン抵抗性を有する強膜を得る。

### 実施例 6

シクロヘキサノン 2 7. 5 g中に実施例 1 の 溶液 ( 固形分 1 8. 3 g ) 4 5. 6 g、種々の アクリレートの混合物 ( テトラエチレングリコ ールジメタクリレート 3. 2 g、トリメチロー ルプロパントリアクリレート 2. 2 g及びペン、 タエリトリトールトリアクリレート 3. 4 g )

て鉛筆硬度はHBである。最難され、次いで現像された板は更に140℃で1時間硬化させる。 十字ハッチ試験はGt0を与え、鉛筆硬度は5 Hであり、塩化メチレン中の抵抗性は>1時間、そしてソルダーパッチ抵抗性は>1分である。 実施例7

シクロヘキサノン27.48中に実施例2の 溶液(固形分18、38)45.78、種々の アクリレートの混合物(テトラエチレングリコ ールジメタクリレート3.28、トリメチロー ルプロパントリアクリレート2.28及びペン タエリトリトールトリアクリレート3.48) 8.88、ウルトラミックスタルク(サイプラ ス)98、染料(オラソールブルーGN:チバーガイギー)0.218、2-メチルー1-C 4-(メチルチオ)フェニル)-2-モルフェ リノブロパン-1-オン1.68、ブタン-2 ーオン0.0'-(メチレンピス(1,4-フ ェニレンイミノカルボニル))ジオキンム4.88、4,4'-ピス(ジエチルアミノ)ペン

8. 8 g、ウルトラミックスタルク(サイプラ ス)9g、染料(オラソールブルーGN:チバ - # (1 + 1) = 0, 2 + # (1 + 1) = 04- (メチルチオ) フェニル) -2-モルフォ リノプロパン-1-オン1. 6g、ブタン-2 - **オン**0, 0' - (メチレンピス(1, 4-7 ェニレンイミノカルポニル)) ジオキシム 4、 8 g 、 4 , 4 ' - ピス (ジエチルアミノ) ペン プフェノン0. 21g及びFC-430(3M 社) 0. 2gを含む溶液を、ナイフ塗布具を使 用して回路板に塗布する。このフィルムを30 分間 8 0 ℃で乾燥して、約 4 0 μm の塗膜の厚 さを得る。この様にして得られた治療を水銀宮 圧ランプを使用して30秒度マスクを通して暴 軍する(試料台からの距離:50cm)。暴露 した試料を75秒間噴霧現像機 (コンヴァック (Convac)、複雜圧力3~4bar)中 で1%炭酸ナトリウム水溶液により現像する。 暴寒され、次いで現像された板は、GtOの十 字ハッチ点 (D1N53151) を有し、そし

77 - 1 > 0 2 1 g R B F C - 4 8 0 (8 M 社) 0. 2gを含む溶液を、ナイフ造布具を使 用して回路板に塗布する。このフィルムを30 分間 8 0 ℃で乾燥して、約 4 0 µmの強膜の厚 さを得る。この機にして得られた途襲を水銀音 圧ランプを使用して60秒間マスクを達して暴 電する(試料台からの距離:50cm)。異態 した試料を45秒間噴霧現像機(コンヴァック (Convac), 喷雾圧力3~4bar)中 で1%炭酸ナトリウム水溶液により現像する。 暴露され、次いで現像された板は、GtOの十 字ハッチ点 (DIN53151) を有し、そし て鉛筆硬度はHBである。暴露され、次いで現 **像された板は更に140℃で1時間硬化させる。** 十字ハッチ試験はGt1を与え、鉛筆硬度は7 Hであり、塩化メチレン中の抵抗性は>1時間 、そしてソルダーパッチ抵抗性は>1分である。 实施例 8

シクロヘキサノン27. 5 g中に実施例3の 結合用ポリマー18. 3 g、種々のアクリレー

トの混合物(テトラエチレングリコールジメタ クリレート3.2g、トリメチロールプロパン トリアクリレート2、2g及びペンタエリトリ トールトリアクリレート3、4g) 8、8g、 ウルトラミックスタルク(サイブラス)9g、 染料 (オラソールブルーGN:チパーガイギー ) 0. 21g、2-メチル-1-(4-(メチ ルチオ) フェニル) - 2 - モルフォリノプロパ ン-1-オン1. 6g、ブタン-2-オンO, 0'-(メチレンビス(1、4-フェニレンイ ミノカルポニル)〕 ジオキシム 4 。 8 g 、 4 。 4' - ビス(ジエチルアミノ)ペンゾフェノン 0. 21g及UFC-430(3M社)0.2 gを含む溶液を、ナイフ塗布具を使用して函路 板に塗布する。このフィルムを15分間80℃ で乾燥して、約40μmの逾数の厚さを得る。 この様にして得られた塗膜を水銀高圧ランプを 使用して15秒間マスクを通して暴傷する(鉄 料合からの距離:50cm)。暴露した試料を 1%炭酸ナトリウム水溶液中で現像する。 基準

され、次いで現像された板は、 G t 0 の十字ハッチ点 (D I N 5 3 1 5 1) を有し、そして鉛 象硬度は H B である。 暴露され、次いで現像された板は更に 1 4 0 ℃で1 時間硬化させる。 十字ハッチ試験は G t 0 を与え、鉛板硬度は 3 H であり、塩化メチレン中の抵抗性は > 1 時間、 そしてソルダーバッチ抵抗性は > 1 0 秒である。 実施例 9

エチルグリコールエーテルアセテート 4 4.6 g中に実施例 4 の溶液 (固形分 1 1 . 3 g)
2 2 . 6 g、スクリブセット® 5 5 0 (スチレンとマレイン酸をベースとする部分的にエステル化されたコポリマー,モンサント製) 3 . 9 6 g、スクリブセット® 5 4 0 (スチレンとマレイン酸をベースとする部分的にエステル化されたコポリマー,モンサント製) 3 . 9 8 g、セイン酸をベースとする部分的にエステル化されたコポリマー,モンサント製) 3 . 9 8 g、セールプロペントの混合物 (テトラエチレングリコールジメタクリレート 2 . 3 g、トリメチロールプロペントリアクリレート 2 . 1 g、ペンタエリトリトールトリアクリレート 2 . 5

g 及びエトキシル化トリメチロールプロパント リアクリレート1. 7g) 8. 6g、ウルトラ ミックスタルク (サイプラス). 7g、染料 (オ ラソールブルーGN;チパーガイギー)O. 2 1 g、 2 - メチル-1 - (4 - (メチルチオ) フェニル) -2-モルフォリノプロパン-1-オン1. 6g、ブタン-2-オン0, 0'-( メチレンピス(1、 4 - フェニレンイミノカル ポニル)〕ジオキシム7.0g、4,4゜-ビ ス (ジエチルアミノ) ペンゾフェノン 0. 2 1 g及びFC-430(3M社)0,2gを含む 路液を、ナイフ盤布具を使用して回路板に塗布 する。このフィルムを15分間80℃で乾燥し て、約30μmの強膜の厚さを得る。この様に して得られた塗漑を水銀高圧ランプを使用して 15秒間マスクを避して暴露する(試料台から の距離:50 cm)。暴露した試料を1%炭酸 ナトリウム水溶液中で現像する。暴露され、次 いで現像された板は、GtOの十字ハッチ点( D I N 5 3 1 5 1 ) を 存し、 そして 新華 硬度は

HBである。暴露され、次いで現像された板は 更に140℃で1時間硬化させる。十字ハッチ 試験はGt0を与え、鉛筆硬度は3Hであり、 塩化メチレン中の抵抗性は>1時間、そしてソ ルダーバッチ抵抗性は>1分である。

特許出職人 チパーガイギー

アクチェンゲゼルシャフト

代理人 弁理士 専 優 美

(ほか2名)

**@発 明 者 ジュリアノ オイグス スイス国,4452 イチンゲン,**ローゼンヴェーク 3 ター